Изучение плазмы газового разряда в неоне

Каспаров Николай, Б01-304

November 29, 2024

Цель работы:

- Изучение вольт-амперной характеристики тлеющего разряда;
- Изучение свойств плазмы методом зондовых характеристик.

В работе используются:

- Стеклянная газоразрядная трубка, наполненная неоном;
- Высоковольтный источник питания (ВИП);
- Источник питания постоянного тока;
- Делитель напряжения;
- Потенциометр, амперметры, вольтметры, переключатели.

1 Теоретическое введение

1.1 Плазменная частота

Выделим в нейтральной плазме некоторый объём в виде параллелепипеда (см. рис. 1).

 $\begin{array}{c} + \\ + \\ + \\ \end{array}$

Рисунок 1: Плазменные колебания

Обозначим концентрацию электронов как n_e , однозарядных ионов: n_i , тогда $n_i = n_e$. Пусть все электроны сместились на расстояние x относительно ионов. Будем считать, что ионы неподвижны, тогда на боковых гранях параллелепипеда возникнут нескомпенсированные поверхностные заряды с плотностью

$$\sigma = \pm n_e e \Delta x. \tag{1}$$

Аналогично конденсатору, они создадут электрическое поле

$$E = 4\pi n_e e \Delta x. \tag{2}$$

В свою очередь это поле будет действовать на электроны:

$$\frac{d^2\Delta x}{dt^2} = -\frac{eE}{m} = -\frac{4\pi n_e e^2}{m} \Delta x. \tag{3}$$

Видно, что полученное уравнение описывает гармонические колебания с частотой

$$w_p = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}} \tag{4}$$

Таким образом, мы получили частоту коллективных колебаний электронов относительно квазинейтрального состояния. Такие колебания на зывают ленгиюровскими, а частоту ω_p — плазменной или ленгиюровской.

1.2 Плазменная частота

Плазменные колебания могут быть возбуждены как за счёт внешнего воздействия (например, при прохождении электромагнитной волны), так и за счёт тепловой энергии, содержащейся непосредственно в плазме. Оценим амплитуду колебаний в последнем случае.

Средняя скорость теплового движения электронов по порядку величины равна

$$v_e \sim \sqrt{\frac{kT_e}{m_e}}. (5)$$

Амплитуду r колебаний электронов относительно ионов можно оценить как смещение с тепловой скоростью $\overline{v_e}$ за характерное время плазменных колбений $1/\omega_n$. Полученную величину обозначают как

$$r_D = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n_e e^2}} \sim \frac{\overline{v_e}}{\omega_p} \tag{6}$$

и называют дебаевским радиусом (или дебаевской длиной). Это — ещё один важный плазменный параметр, задающий характерный пространственный масштаб многих плазменных явлений.

1.3 Измерения методом одиночного зонда

При внесении проводника в плазму, он подвергается «бомбардировке» со стороны её заряженных частиц. Как известно из молекулярной физики, число частиц, ударяющихся в идеальном газе в секунду о единичную поверхность, равно:

$$j = \frac{1}{4}n\overline{v},\tag{7}$$

и так как скорость электронов, очевидно, больше скоростей ионов, проводник зарядится отрицательно.

Найдем отрицательный потенциал U_f (относительно плазмы), который также называется плавающим. В равновесии, если бы $U_f = 0$, то электронный и ионные токи было бы равны:

$$I_{e0} = \frac{n\overline{v}_e}{4}eS, \qquad I_{i0} = \frac{n\overline{v}_i}{4}eS, \tag{8}$$

Теперь учтем, что $U_f \neq 0$. На ионный ток это почти не повлияет: $I_i \approx I_{i0}$. Электронный же ток уменьшится, посколько лишь часть электронов, летящих к зонду, способна преодолеть потенциальный барьер. Из распределения Больцмана:

$$I_e = I_{e0} \exp\left(\frac{eU_f}{kT_e}\right),\tag{9}$$

где $U_f < 0$, поэтому $I_e < I_{e0}$.

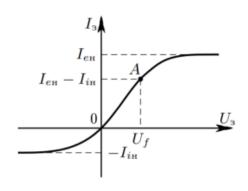


Рисунок 2: Ток насы

Будем подавать потенциал U_3 на зонд и снимать значение зондового тока I_3 . Максимальное значение тока $I_{\rm en}$ – электронный ток насыщения, а минимальное $I_{\rm in}$ – ионный ток насыщения. Значение из эмпирической формулы Бомона:

$$I_{\rm ih} = 0.4 neS \sqrt{\frac{2kT_e}{m_i}} \tag{10}$$

1.4 Измерения методом двойного зонда

Двойным зондом называется система, состоящая из двух одинаковых зондов, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Между зондами создаётся разность потенциалов U, которая по величине много меньше плавающего потенциала $|U| \ll |U_f|$.

При небольших разностях потенциалов ионные токи на оба зонда близки к току насыщения и компенсируют друг друга, а

значит величина результирующего тока полностью связана с разностью электронных токов. Пусть потенциалы на зондах равны:

$$U_1 = U_f + \Delta U_1, \qquad U_2 = U_f + \Delta U_2,$$
 (11)

где $\Delta U_1, \Delta U_2 \ll U_f$. Напряжение между зондами равно

$$U = U_2 - U_1 = \Delta U_2 - \Delta U_1. \tag{12}$$

Найдем ток, приходящий на первый электрод:

$$I_1 = I_{\rm ih} - I_{\rm e0} \exp\left(\frac{eU_1}{kT_e}\right) = I_{\rm ih} - \left[I_{\rm e0} \exp\left(\frac{eU_f}{kT_e}\right)\right] \exp\left(\frac{e\Delta U_1}{kT_e}\right),\tag{13}$$

но заметим, что при $\Delta U_1=0$ ($U_1=U_f$) электронный и ионный токи компенсируют друг друга. Значит,

$$I_1 = I_{\rm in} - I_{\rm e0} \exp\left(\frac{e\Delta U_1}{kT_e}\right),\tag{14}$$

$$I_2 = I_{\rm in} - I_{\rm e0} \exp\left(\frac{e\Delta U_2}{kT_e}\right),\tag{15}$$

Из последовательности соединения видно, что $I_1 = -I_2 = I$, значит

$$U = \Delta U_1 - \Delta U_2 = \frac{kT_e}{e} \ln \frac{I_{iH} - I}{I_{iH} + I},$$
(16)

и, разрешая это равенство относительно I, получаем:

$$I = I_{\rm in} \, \text{th} \, \frac{eU}{2kT_e}. \tag{17}$$

Отсюда, используя приближение th $x \approx x$, получим

$$kT_e = \frac{1}{2} \frac{eI_{\text{iH}}}{\frac{dI}{dU}|_{U=0}},$$
 (18)

где $\frac{dI}{dU}|_{U=0}$ - наклон характеристики зонда вблизи начала координат. В действительности же, наш результат отличается от реального существованием наклона у асимптот в области больших |U|, что связано с ускорением частиц плазмы приложенным полем, которое не учтено при выводе

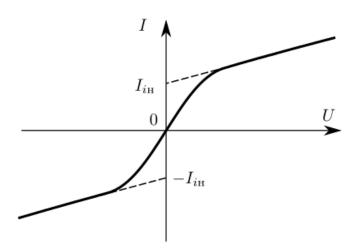


Рисунок 3: ВАХ двойного зонда

2 Описание установки

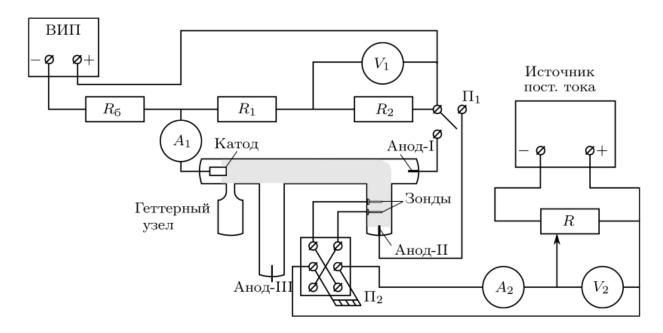


Рисунок 4: Схема установки

Стеклянная газоразрядная трубка имеет холодный (ненакаливаемый) полый катод, три анода и *геттерный* узел – стеклянный баллон, на внутреннюю повехность которого напылена газопоглощающая плёнка (*геттер*). Трубка наполнена изотопом неона 22 Ne при давлении 2 мм рт. ст. Катод и один из анодом (I и II) с помощью переключателя Π_1 подключается через балластный резистор R_6 (≈ 450 кОм) к регулируемому ВИП с выкодным напряжением до 4 кВ.

При подключении к ВИП анода-I между ним и катодом возникает газовый разряд. Ток разряда измеряется миллиамперметром A_1 , а падение напряжения на разрядной трубке – цифровым вольтметром V_1 , подключённым к трубке черезе высокоомный (25 МОм) делитель напряжения с коэффициентом $(R_1 + R_2)/R_2 = 10$.

При подключении к ВИП анода-II разряд возникает в пространстве между катодом и анодом-II, где находятся двойной зонд, используемый для диагностики плазмы положительного столба. Зонды изготовлены из молибденовой проволоки диаметром d=0.2 мм и имеют длину l=5.2 мм. Они подключены к источнику питания GPS через потенциометр R. Переключатель Π_2 позволяет изменять полярность напряжения на зондах. Величина напряжения на зондах изменяеься с помощью дискретного переключателя «V» выходного напряжения источника питания и потенциометра R, а измеряется цифровым вольтметром V_2 . Для измерения зондового тока используется мультиметр A_2 .

3 Ход работы

3.1 Вольт-амперная характеристика разряда

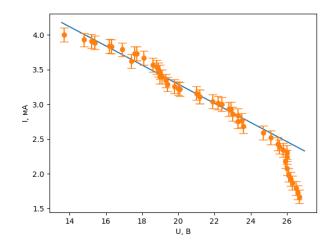


Рисунок 5: ВАХ разряда

Будем увеличивать напряжение ВИП, пока не произойдет зажигание разряда. Затем обратно, до исчезновения разряда. Данные нанесем на график (Рис. 5):

Разницы в результатах при повышении и понижении напряжения обнаружено не было. Аппроксимируем график прямой (используя МНК).

Найдем дидифференциальное сопротивление разряда:

$$R_{\rm диф} = \frac{dU}{dI} = (-7.0 \pm 0.2) \text{ кОм}$$
 (19)

Как мы может увидеть из Рис. 6, участок разряда в нашем случае соответсвует фрагменту $Д\Gamma$ - поднормальному тлеющему разряду.

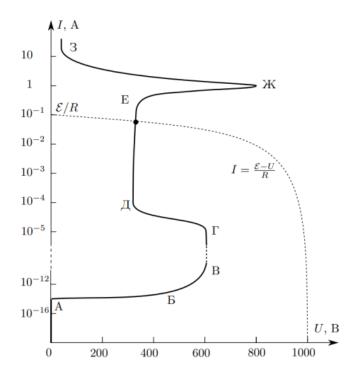


Рисунок 6: ВАХ разряда

3.2 Зондовые характеристики

Снимем ВАХ двойного зонда для токов разряда 2 мА, 3 мА и 4 мА. Каждый график отцентрируем и нанесем на общую систему координат:

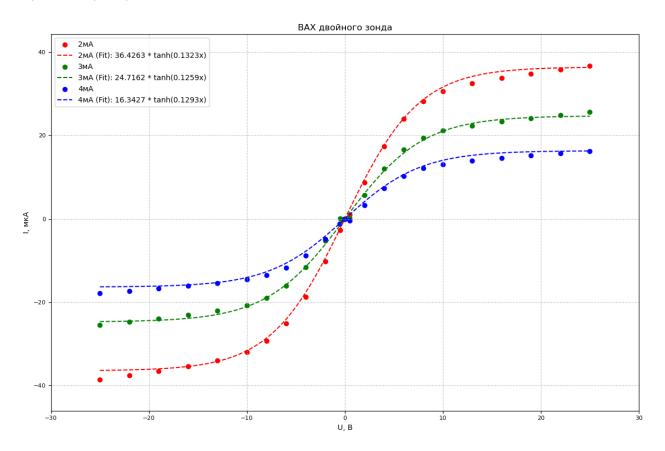


Рисунок 7: ВАХ двойного зонда

Вспомним формулу (17):

$$I = I_{\rm in} \, {\rm th} \, \frac{eU}{2kT_e}.$$

Из графика получим ионный ток насыщения для разных сил тока, а также температуру электронов T_e . Используя эмпирическую формулу Бомона (10), найдем концентрацию ионов и электронов в плазме (считаем, что они одинаковы).

$$n = \frac{I_i}{0.4eS} \sqrt{\frac{m_i}{e}B}$$
 , где $B = \frac{e}{2kT_e}$ (20)

Рассчитаем также плазменную частоту колебаний электронов w_q , используя формулу (4).

$$w_p = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}} \tag{21}$$

Также вычислим дебаевский и электронный радиусы экранирования по формуле (6), а также оценочное среднее число ионов в дебаевской сфере по формуле:

$$N_e = -\frac{4}{3}\pi r_D^3 n_e (22)$$

Чтобы оценить долю ионизированных молекул, оценим давление внутри трубки в 2 торр Все данные организуем в общую итоговую таблицу:

$I_{\rm p}$, мА	2.00 ± 0.01	3.00 ± 0.01	4.00 ± 0.01
T_e , эВ	3.9 ± 0.5	4.0 ± 0.6	3.9 ± 0.6
$n_e, 10^{16} \text{ m}^{-3}$	1.2 ± 0.1	1.8 ± 0.1	2.7 ± 0.1
$\omega_p, \ 10^9 \frac{\text{рад}}{\text{c}}$	6.1 ± 0.3	7.5 ± 0.4	9.2 ± 0.5
$r_{De}, 10^{-6} \text{ M}$	1.4 ± 0.2	1.1 ± 0.1	0.9 ± 0.1
$r_D, 10^{-5} \text{ M}$	1.1 ± 0.1	0.9 ± 0.1	0.7 ± 0.1
N_D	70 ± 20	50 ± 20	40 ± 10
$\alpha, 10^{-7}$	≈ 4	≈ 7	≈ 12

Таблица 1: Параметры тлеющего разряда

4 Вывод

В этой работе мы получили ВАХ разряда, по наклону которой определили максимальное дифференциальное сопротивление. Мы также определили, что работаем с поднормальным тлеющим разрядом.

Мы построили семейство зондовых характеристик, благодаря которым определили ионный ток насыщения, температуру электронов, концентрацию электронов и ионов в плазме, частоту колебаний электронов, электронную поляризационную длину r_{De} и дебаевский радиус экранирования r_D .

Определив среднее число ионов в дебаевской сфере N_D , мы увидели, что $N_D\gg 1$, что означает, что плазму разряда можно считать идеальной. Также была определена степень ионизации плазмы.

Наибольший вклад в погрешность внесла аппроксимация BAX двойного зонда. Чтобы улучшить точность, надо придумать способ более точно описывать графики I(U).